This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

⑪特許出願公開

平1-246835 ② 公開特許公報(A)

Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

49公開 平成1年(1989)10月2日

H 01 L 21/304 3/04 B 08 B 21/304

21/306

E-8831-5F

Z - 7817 - 3B-8831-5F U-7342-5F

審杳請求 有 請求項の数 1 (全5頁)

69発明の名称

H 01 L

ウエハ処理装置

21)特 頣 昭63-75342

22出 昭63(1988)3月29日

屋 個発 明者 坂

和裕

神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1 東芝マイコンエン

ジニアリング株式会社内

株式会社東芝 ⑪出 願 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

東芝マイコンエンジニ 額 ②出 人

神奈川県川崎市川崎区駅前本町25-1

アリング株式会社

個代 理 人

弁理士 鈴江 武彦

外2名

細

1. 発明の名称

ウェハ処理装置

2. 特許請求の範囲

半導体ウェバの支持体と、少くとも前配ウェ ハ表面のエッツ部をシールするシール体と、前記 半導体ウェハの表面器出部のみに処理液を供給す る手段とを具備したことを特徴とするウエハ処理 装 置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は半導体ウェハの表面処理を行たうウ エハ処理装置に関する。

(従来の技術)

従来、ウェハの表面処理は、ウェハをキャリ アに入れて、直接処理液の中に投入することによ り行なっていた。第8図はこの様子を示すもので、 図中10はウエハ、11はキャリア、12は処理 液供給部、13は処理液、14は処理槽、15は

排放口である。

(発明が解決しよりとする課題)

しかしながら上記従来の方法では、ウエハ11 の裏面やエッツ部も同時に処理液13で処理して しまうので、プロセス上不都合が生じてしまう場 合があった。

本発明は上述した従来技術の欠点を解消するた めになされたもので、ウェハの裏面やエッジ部に 処理液を接液させずに、ウエハ袋面だけを処理す ることのできるウェハ処理装置を提供することを 目的とする。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段と作用)

本発明は、半導体ウェハの支持体と、少くと も前記ウエハ表面のエッジ部をシールするシール 体と、前記半導体ウェハの表面露出部のみに処理 液を供給する手段とを具備したことを特徴とする ウェハ処理装置である。即ち本発明は上記目的を 実現するために、ウェハを支持体で支持させ、ウ エハのエッジ部をシール体によってシールし、処 理液がウェハ級面及びェッジ部に接液しないようにして、ウェハ表面だけを処理することができる ウェハ処理装置である。

以下図面をお照して本発明の一奥施例を説明 する。第1図は同実施例の断面的構成図、第2図 は同要部平面図であるが、 図中第8図のものと対 応する個所には対応符号を用いる。即ち第1図に 示すよりに、ウエハ10をウエハ敬せ台(ウエハ 支持体)16上に収せ、エアシリンダ18によっ てシールリング(シール体)11亿ウエハ10の エッジ部を押し当てる。このようにしてウェハ10 は、第2図に示すようにシールリング11によっ て、オリフラ部19も含めてエッジ部をシールさ れかつ英面もシールされたことになる。このよう にウエハ10をシール後、処理被13はウエハ10 上に、処理液供給部12によって供給される。処 理が終ると、エアシリンダ18によって、ウエハ 叡せ台16は2点鎖線の位置まで引き下げられ、 との時処理液13は排液口15より排出される。

れは、処理液13が各ウエハ10上を流れるより にすれば、複数枚のウエハ10の表面だけを同時 に処理することができるものである。

第5回、第6回は第3回のシール治具21の積層の仕方を更に具体的に示した例の要部の分解斜視図である。このようにシール治具21の両端側に孔を設け、シール治具21の内壁の環状海21にシールリング11をはめ込み、シール治具21に体体22を挿通させて各シール治具21間にウエハ10をシール配置し、これを複数処理することができる。

第7図は、第3図のシール治具を立てるようにして処理権14内に配置し、処理被13を下側から供給し、上側でオーバーフローさせる場合のので、との場合良い結果が得られている。その理由は、処理被13の流れがとどこうらず、ウェハ10上に堆積される膜厚が均一化されるからであると大に堆積される膜厚が均一化されるからであると大を打る。その具体例として、ウェハ SiO2 成膜比較アータを示す。即ち処理液に弗酸系 SiO2 溶液を用いた場合、第7図のシール治具外に置いた

その後ウェハ 1 0 は取り出され、処理工程が終了 する。

上記実施例によれば、ウェハ11の表面処理に おいて、ウェハ11の展面及びエッジ部を処理す ることなく、ウェハ表面のみ処理することができ るものである。

上記実施例はウェハ1枚に対してのものであるが、ウェハを複数枚同時に処理することも可能である。第3図、第4図はその例を示すもので、同図(a)は平面図、同図(b)は一部切欠側面図である。

第3図の実施例は、ウェハ支持体としての役目を兼ねるシール治具21の上にウェハ10を載せ、そのエッジ部をシールリング11でシールしたものを複数階積み重ねたもので、これを処理権の中に置いて、処理液通過路20を通過する処理液13で各ウェハ10の装面だけを処理することができる。

第4図の実施例は、ウェハ散せ台16の上に、 各ウエハ10を平面的に位置をずらせて複数枚散 せ、シール体17を上から被せたものである。と

エハ(図示せず)の膜厚は355%であるのに対し、シール治具内のウエハ10の膜厚は340%であり、また双方の膜厚の分布(差)は2.6%で、シール治具21の使用によって成膜に差異はほとんどなく、従って第7図のような処理においては、問題は生じなかった。

上記のように本発明においては、ウェハの裏面及びエッジ部は研摩していないから、そこをシールする。もしシールしないと、ウェハ裏面とエッジ部は表面があらくなっていて、成膜がばらついたりして、後工程でごみ等の問題となるが、本発明によればこのような問題もなくなるものである。

以上説明した如く本発明によれば、ウェハの 装面処理において、ウェハの裏面及びェッジ部を 処理することなく、ウェハ表面のみ処理すること ができ、プロセス上徑々の効果が得られるもので ある。

4. 図面の簡単な説明

[発明の効果]

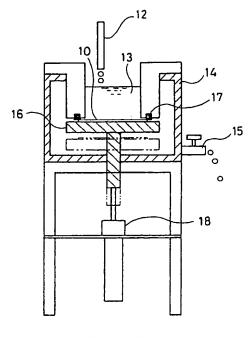
第1図は本発明の一実施例の断面的構成図、

特別平1-246835(3)

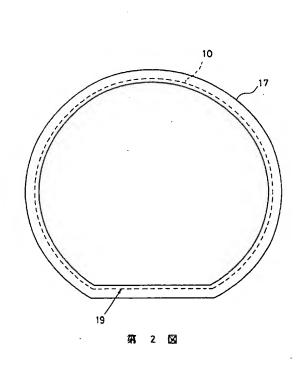
第2 図はその 要部平面図、 第3 図(a) は 本発明の異なる 実施例の平面図、 同図(b) はその 一部切欠 側面図、 第4 図(a) は本発明の更に異なる 実施例の平面図、 同図(b) はその一部切欠 側面図、 第5 図、 第6 図は第3 図のシール治具の 積層の 仕方の 具体例の要部の分解射視図、 第7 図は本発明の更に異なる 実施例の断面的構成図、 第8 図は従来装置の断面図である。

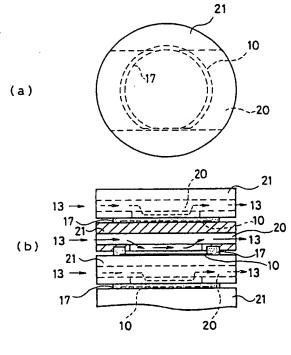
10…ウェハ、12…処理液供給部、13…処理液、14…処理梢、15…排液口、16…ウエハ戦置台、17…シールリング(シール体)、18…エアシリンダ、20…処理液通過路、21…シール治具。

出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦



第 1 図





第 3 🗵

